

(19)
(12)

(KR)
(A)

(51) Int. Cl.⁷
H05B 33/10

(11)
(43)

2003-0074186
2003 09 19

(21) 10-2003-0013282
(22) 2003 03 04

(30) JP-P-2002-00059590 2002 03 05 (JP)
JP-P-2003-00022757 2003 01 30 (JP)

(71) 가 가 2 5 5

(72) 1-45-11

가 1-501

가 2-17-43

(74)

:

(54)

EL (40) , EL (50) , EL (50) 77ng/cm³ , 2 , 2 (40) 가

2

, , , ,

- 1 (a) 1 , 1 (c) 1 , 1 (b) .
 - 2 (a) , 2 (c) EL , 2 (b) 2 .
 - 3 1 .
 - 4 2 .
 - 5 .
 - 6 3 SiN_x , .
- < >
- 10 :
 - 30 : 1
 - 32 : TFT
 - 34 :
 - 40 : 2
 - 48 :
 - 50 : EL

가 (「 EL 」 가) , 가 , (「 EL) , EL 가 . , (Thin Film Transistor : TFT) EL 가 EL EL 가 (EL , SiO_x 1(11-260562)) .

EL , TFT EL 가 EL
 EL
 1 EL SiO_x SiO_x , SiO_x
 EL
 EL
 1
 2
 154ng/cm³ 가
 77ng/cm³ 가
 pg/cm²
 10pg/cm² 7.7ng/cm³=1pg/cm² 20pg/cm² 가 1,300nm
 가
 1 , 200 , 270 , 1 1 3 ,
 가
 가
 1 , 1
 1 , 2
 1 , SiN_x , 1 , Si
 2
 1 , 1
 2
 154ng/cm³
 2
 가
 < 1 >
 1 2 1 EL 1 (a)
 (14) , (10) , SiO₂

(12) CVD (12) CVD
a-Si, a-Si, a-Si p-Si, p-Si
(14)
D 1 (b) (20) SiO₂ (18) (Cr), (16) (Mo), p-Si, SiN (14) CV (18)
(20) (14)
1 (c) 1 (30) P N (20) 2 (18) 1 (14) (16)
(20) (14) (20) 2 (18) SiN (Al)
1 (22) SiO₂ (14) (24) (26) (28) (30) (30) (26)
(28) TFT (32)
2 (a) (34) (30) (34) (28) (Indium Tin Oxide : ITO)
2 (b) (34) 2 (40) (34) (40) (34)
2 (40) (40) (34)
1 (40) 2 (40) (40) 2 (40) 385ng/cm³ EL
(40) EL 가 1,300nm 50pg/cm²
(40) 2 (40) 2 (40) EL 2
100000 77ng/cm³ 100000 20% 20% 154ng/cm³
100000 가 20% 154ng/cm³ 가
77ng/cm³ 가
3 2 (40) 77ng/cm³ 가
() 가
가 가 2 (40) 385ng/cm³ EL
300 30 100 1000 가
, 270 가 300 TFT (TFT)
EL
, 150 10 , 220 2 , 100000
EL (40) , 200 270
1 3 가 , 220 2 가

1×10^{14} $1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-2}$, 2 (40) .
 ()
 2 (40) TFT (32), 2 (40)
 , 10mW/cm² 1 5, 2 (40) (40)
 2 (b) 가, 2 (40), (34) . 2
 (40), (34),
 가, 2 (40),
 , 2 (40)
 , 2 (40)
 4 2 (40) Ar
 cm⁻² $1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$, Ar, 가 140keV, 1×10^{14} EL
 2 (40) 가, EL
 < 3 >
 3 (50), 2 (40), 2 (40) EL
 , 3 1, 1 가, 1 3
 , EL
 ()
 2 (40), EL (50), SiN_x, Si
 . SiN_x, CVD, SiO_x, NH₃/SiH₄ 가 가 1 3, 가 200, CV
 5 50Pa, RF 가 1 3W/cm², 가 0.1 0.5, 가 100, 5 50Pa, RF 가 2 4W/
 D cm²
 ()
 2 (40), 2 EL (50) (40),
 , 2
 2 (b) 가, 2 (40), (34) . 2
 (40), 1 (34),
 가, 가 (34),
 , 5 가 (60),
 , (60) .

6 2 (40) SiN_x, 2 (40) ()
 , . EL
 , . SiN_x, EL
 , . 가가 ,
 , EL EL
 , EL
 , 2 (40) , EL (50)
 , EL (50) , 가
 EL (50) , 2 (40) ,
 , 가

EL

EL

(57)

1.

, 1

1

2

2.

1

154ng/cm³ 가

3.

1

2

가

4.

, 1 , ,
 1 , ,
 , 200 270 1 3 가 ,
 ,
 2

5.

, 1 , ,
 1 , ,
 ,
 ,
 2

6.

, 1 , ,
 1 , ,
 , SiN_x , Si
 ,
 ,
 2

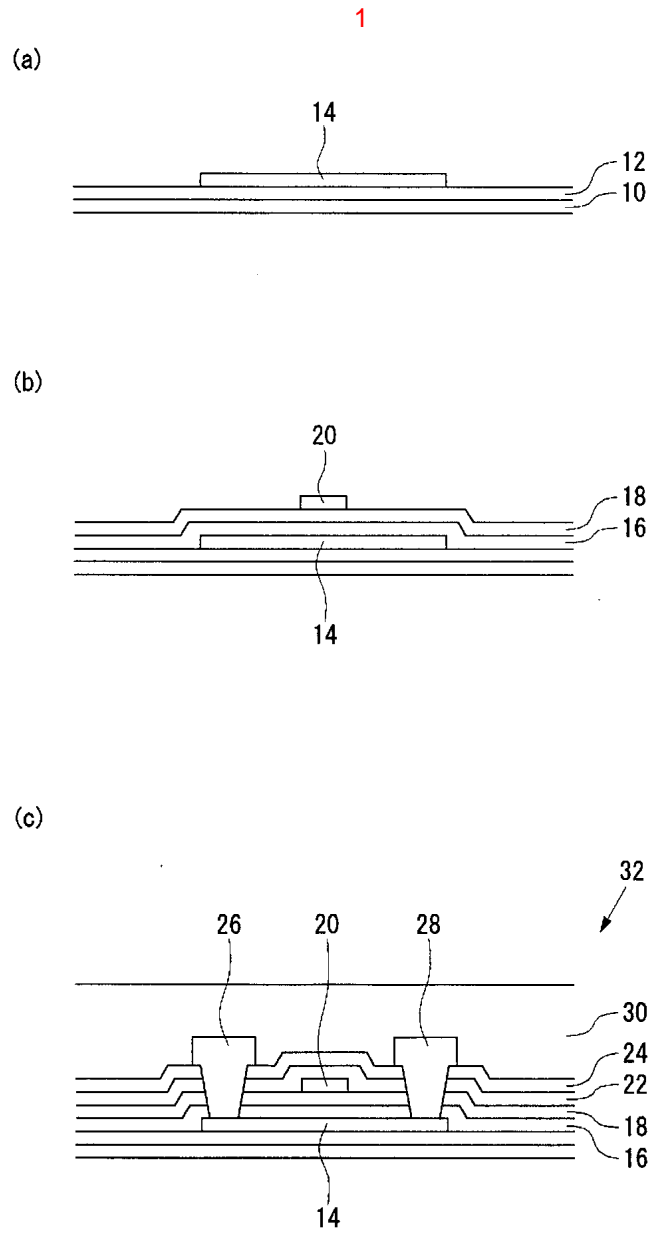
7.

, 1 , ,
 1 , ,
 , ,
 ,
 2

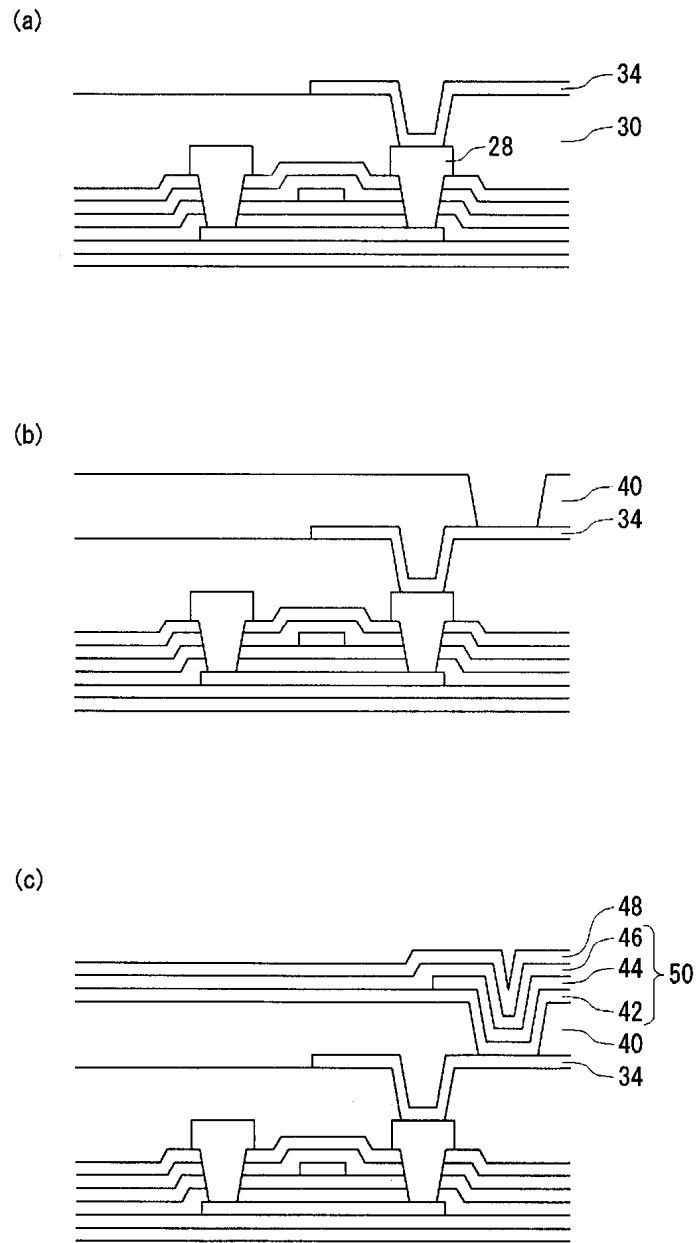
8.

1 , ,
 1 , 154ng/cm³ ,

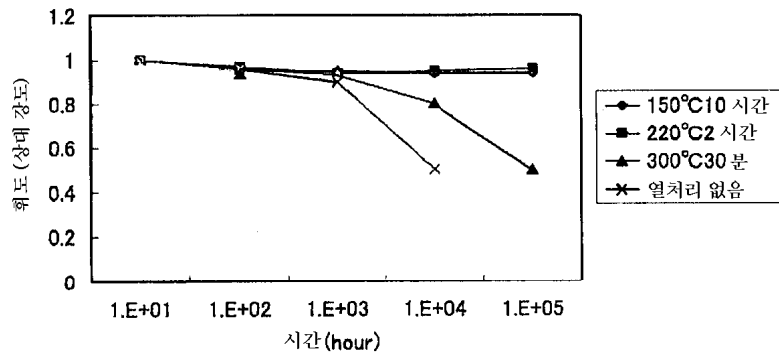
2

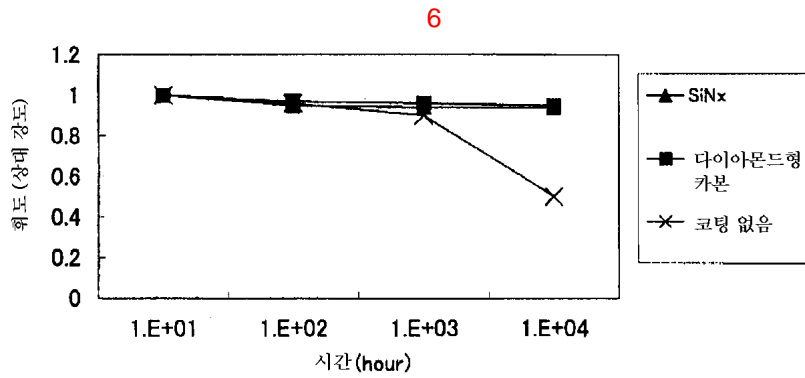
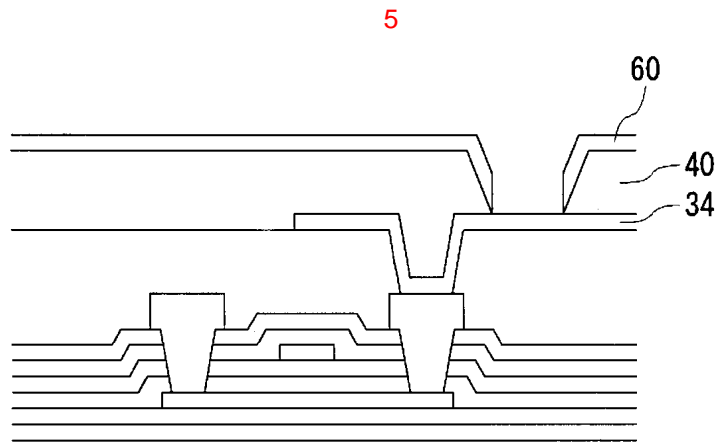
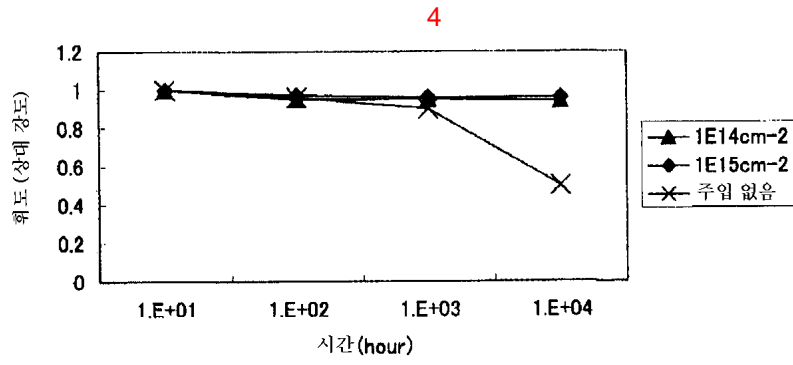


2



3





专利名称(译)	电致发光面板及其制造方法		
公开(公告)号	KR1020030074186A	公开(公告)日	2003-09-19
申请号	KR1020030013282	申请日	2003-03-04
[标]申请(专利权)人(译)	三洋电机株式会社 山洋电气株式会社		
申请(专利权)人(译)	三洋电机有限公司是分租		
当前申请(专利权)人(译)	三洋电机有限公司是分租		
[标]发明人	ABE HISASHI 아베히사시 SUZUKI KOJI 스즈끼고지 HASEGAWA ISAO 하세가와이사오		
发明人	아베히사시 스즈끼고지 하세가와이사오		
IPC分类号	H01L51/50 H01L27/32 H05B33/10 H01L51/52 H05B33/22 C01B32/949		
CPC分类号	H01L27/3246 H01L29/4908 H01L51/5237 H01L51/5253		
代理人(译)	LEE, JUNG HEE CHU, 晟敏		
优先权	2002059590 2002-03-05 JP 2003022757 2003-01-30 JP		
其他公开文献	KR100604279B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

提供了一种具有高可靠性的有机EL面板的制造方法。位于有机电子发光层(50)下层的第二平面绝缘层(40)进行热处理。含水量很大。这包含含水量,其中需要低发光度劣化的有机EL面板可以实现为77ng/cm²该靶盒。作为降低有机电子发光层(50)的水分影响的另一种方法,对第二平面绝缘层(40)进行改性处理。而且,执行封装。电致发光层,热处理,阻挡膜,含水量,平面绝缘层。

